

# 제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영  
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

## E. Compound Semiconductors 분과

Room F

죽실 (본관, 5층)

2013년 2월 6일(수) 12:45-14:00

[WF2-E] Compound Semiconductor V

좌장: 민병규(한국전자통신연구원), 이정희(경북대학교)

- |         |             |  |
|---------|-------------|--|
| WF2-E-1 | 12:45-13:00 | <b>고온 저장 시험에 의한 GaN HEMT 소자의 특성 변화</b><br>이종민, 민병규, 주철원, 임종원, 안호균, 문재경, 남은수<br>한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구부<br>RF 융합부품연구팀   |
| WF2-E-2 | 13:00-13:15 | <b>Polyimide를 이용한 AlGaIn/GaN HFET의 Chip크기 감소 및 신뢰성 향상</b><br>오승규 <sup>1</sup> , 조영제 <sup>2</sup> , 송치균 <sup>1</sup> , 장태훈 <sup>2</sup> , 곽준섭 <sup>1</sup><br><sup>1</sup> 순천대학교 인쇄전자공학과, <sup>2</sup> LG 전자 System IC 연구소 IGBT part  |
| WF2-E-3 | 13:15-13:30 | <b>Packaged AlGaIn/GaN HEMT with 100 W Output Power at 3 GHz</b><br>임종원, 안호균, 강동민, 김성일, 이종민, 이상홍, 민병규, 윤형섭, 주철원,<br>김해천, 문재경, 남은수<br>한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구부<br>RF 융합부품연구팀   |
| WF2-E-4 | 13:30-13:45 | <b>게이트가 장착된 오믹 애노드를 이용한 낮은 문턱전압의 AlGaIn/GaN-on-Si 다이오드 개발</b><br>이재길 <sup>1</sup> , 박봉렬 <sup>1</sup> , 최신희 <sup>1</sup> , 이민성 <sup>2</sup> , 서광석 <sup>2</sup> , 김형탁 <sup>1</sup> , 차호영 <sup>1</sup><br><sup>1</sup> 홍익대학교 전자전기공학부, <sup>2</sup> 서울대학교 전기컴퓨터공학부   |
| WF2-E-5 | 13:45-14:00 | <b>Growth and Device Performance of AlGaIn/GaN Heterostructure on SiC Substrate using High Temperature AlN Buffer Layer</b><br>R. H. Kim <sup>1</sup> , K. S. Im <sup>1</sup> , D. S. Kim <sup>1</sup> , Y. W. Jo <sup>1</sup> , C. H. Won <sup>1</sup> , K. I. Jang <sup>1</sup> , M. K. Kwon <sup>1</sup> , S. M. Jeon <sup>1</sup> , D. H. Son <sup>1</sup> , B. H. Lee <sup>2</sup> , B. O. Lim <sup>2</sup> , G. W. Choi <sup>2</sup> , J. M. Lee <sup>3</sup> , J. S. Lee <sup>3</sup> , and J. H. Lee <sup>1</sup><br><sup>1</sup> School of Electrical Engineering & Computer Science, Kyungpook National University, <sup>2</sup> Samsung Thales Co., Ltd., <sup>3</sup> Agency for Defense Development |